

主旨: 薄膜の制御形成や表面・界面の測定・制御の技術が開発され、様々な分野で応用されている。本研究会では、様々な分野で発展を遂げた表面・界面・薄膜の制御・物理について、計測・理論・表面制御・薄膜形成の第一線で活躍されている研究者をお招きし、ご講演いただく。

場所: TKP 新大阪ビジネスセンター カンファレンスルーム 3B

https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-shinosaka-higashiguchi/access/?ctid=ad_gsa_kk_0201

日時: 2024年12月20日(金)14:00 - 2024年12月21日(土)12:00

参加費: 無料 定員: 50人

申し込み締め切り: 2024年12月10日

申し込み方法: 下記 URL から登録

<https://forms.gle/TQzVUpWd2AdzSBwx6>

12月20日

14:00-14:20 受付

14:20-14:30 開会

14:30-15:00 二次元有機量子ビット配列の表面合成

千葉大学 山田豊和

15:00-15:30 HfO₂系強誘電体薄膜/電極の界面設計による結晶構造制御

東京大学 女屋崇

15:30-16:00 計算科学手法を用いた界面電子構造の解析・予測

神戸大学 小野倫也

16:00-16:30 休憩

16:30-17:00 多層薄膜界面の可視化と制御に向けた角度分解 XPS ビッグデータ計測シミュレーション技術の開発

シエンタオミクロン株式会社 豊田智史

17:00-17:30 原子状水素を利用した表面改質と薄膜形成技術の開発

兵庫県立大学 部家彰

17:30-18:00 テラヘルツ電磁波発生検出素子応用に向けた低温成長 Bi 系 III-V 族半導体混晶

広島大学 富永依里子

12月21日

9:20-9:30 受付

9:30-10:00 原子間力顕微鏡による光触媒表面の構造と物性計測

ファインセラミックスセンター 勝部大樹

10:00-10:30 制御界面導入による熱電薄膜の高性能化

大阪大学 石部貴史

10:30-10:45 休憩

10:45-11:15 光学的な共鳴を示すシリコンナノ粒子の開発と応用

神戸大学 杉本泰

11:15-11:45 SiC MOSFET 性能向上に向けた SiO₂/SiC 界面制御

関西学院大学 細井卓治

11:45-12:00 閉会

問い合わせ: 中村芳明 (nakamura.yoshiaki.es@osaka-u.ac.jp)